

***SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED
FAST RECOVERY SILICON RECTIFIER***
VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 3.0 Amperes

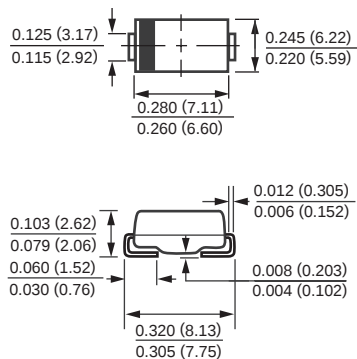
FEATURES

- * Glass passivated device
- * Ideal for surface mounted applications
- * Low leakage current
- * Metallurgically bonded construction
- * Mounting position: Any
- * Weight: 0.24 gram

MECHANICAL DATA

- * Epoxy : Device has UL flammability classification 94V-0

DO-214AB



Dimensions in inches and (millimeters)

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.
Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%.

MAXIMUM RATINGS (At TA = 25°C unless otherwise noted)

RATINGS	SYMBOL	FFM301	FFM302	FFM303	FFM304	FFM305	FFM306	FFM307	UNITS
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	VRRM	50	100	200	400	600	800	1000	Volts
Maximum RMS Voltage	VRMS	35	70	140	280	420	560	700	Volts
Maximum DC Blocking Voltage	VDC	50	100	200	400	600	800	1000	Volts
Maximum Average Forward Rectified Current at TA = 55°C	IO	3.0							Amps
Peak Forward Surge Current 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method)	IFSM	200							Amps
Maximum Thermal Resistance	(Note 2) RθJL	15							°C/W
	(Note 3) RθJA	50							°C/W
Typical Junction Capacitance (Note 1)	CJ	60							pF
Operating and Storage Temperature Range	TJ, TSTG	-55 to + 150							°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (At TA = 25°C unless otherwise noted)

CHARACTERISTICS	SYMBOL	FFM301	FFM302	FFM303	FFM304	FFM305	FFM306	FFM307	UNITS
Maximum Forward Voltage at 3.0A DC	VF	1.3							Volts
Maximum Full Load Reverse Current, Full cycle Average at TA=55°C	IR	50							uAmps
Maximum DC Reverse Current at @TA = 25°C		10							uAmps
Rated DC Blocking Voltage @TA = 125°C		300							uAmps
Maximum Reverse Recovery Time (Note 4)	trr	150				250	500		nSec

- NOTES : 1. Measured at 1.0 MHz and applied average voltage of 4.0VDC
 2. Thermal resistance junction to terminal 6.0mm² copper pads to each terminal.
 3. Thermal resistance junction to ambient, 6.0mm² copper pads to each terminal.
 4. Test Conditions: IF = 0.5A, IR = -1.0A, IRR = -0.25A

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (FFM301 THRU FFM307)

FIG. 1 - TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE

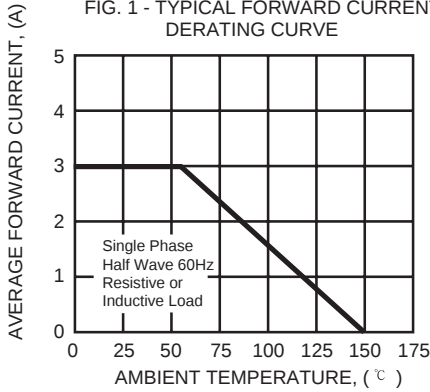


FIG. 2 - MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT

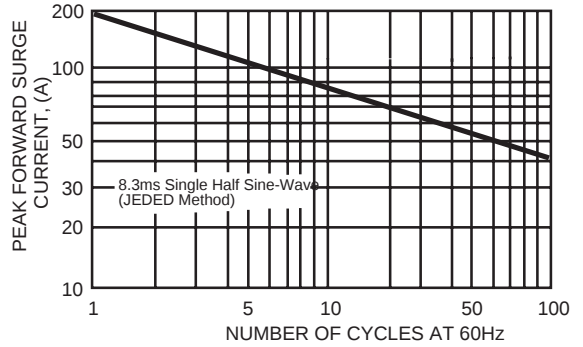


FIG. 3 - TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS

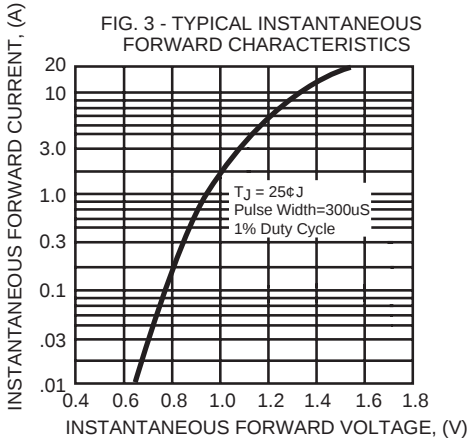


FIG. 4 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE

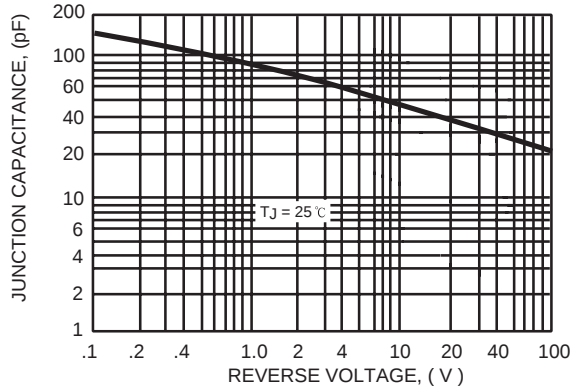
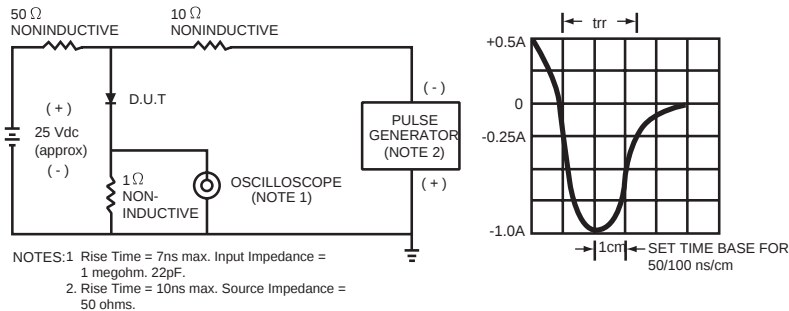
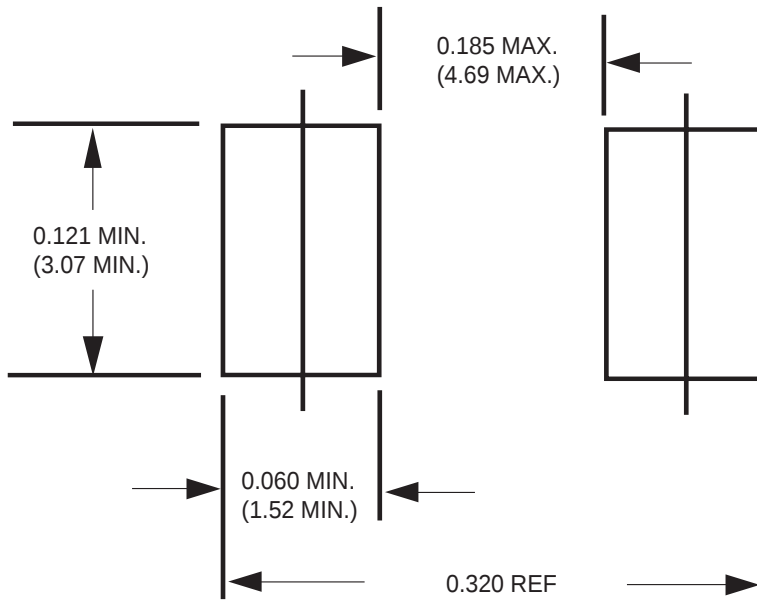


FIG. 5 - TEST CIRCUIT DIAGRAM AND REVERSE RECOVERY TIME CHARACTERISTIC



Mounting Pad Layout



Dimensions in inches and (millimeters)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331